

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : H01L 21/00	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/67299 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 9. November 2000 (09.11.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/03664 (22) Internationales Anmeldedatum: 22. April 2000 (22.04.00) (30) Prioritätsdaten: 199 20 322.9 3. Mai 1999 (03.05.99) DE 199 27 962.4 18. Juni 1999 (18.06.99) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): STEAG RTP SYSTEMS GMBH [DE/DE]; Daimlerstrasse 10, D-89160 Dornstadt (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LERCH, Wilfried [DE/DE]; Zwischen den Wiesen 17, D-89160 Dornstadt (DE). ROTHERS, Georg [DE/DE]; Weseler Strasse 37, D-48249 Dülmen (DE). MARCUS, Steven, D. [US/US]; 1142 East Vinedo Lane, Tempe, AZ 85284 (US).		(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>
(54) Title: METHOD FOR GENERATING DEFECTS IN A GRID SUPPORT OF A SEMICONDUCTOR MATERIAL (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERZEUGEN VON DEFECTEN IN EINER GITTERSTRUKTUR EINES HALBLEITERMATERIALS (57) Abstract In order to precisely control grid defects in a semiconductor material in a simple and cost-effective manner, the invention provides a method for generating defects in a grid support of a semiconductor material, during the thermal treatment of said material. The concentration and/or distribution of defects or blank sections is controlled in conjunction with a process gas atmosphere. (57) Zusammenfassung Um auf einfache und kostengünstige Weise eine genaue Steuerung von Gitterdefekten in einem Halbleitermaterial zu ermöglichen, ist ein Verfahren zum Erzeugen von Defekten in einer Gitterstruktur eines Halbleitermaterials während dessen thermischer Behandlung vorgesehen, bei dem die Defekt- bzw. Fehlstellenkonzentration und/oder-verteilung in Abhängigkeit von einer Prozessgasatmosphäre gesteuert wird.		